



La UGR facilita el acceso de los grupos de diseño europeo a la tecnología de fabricación electrónica más avanzada que existe a nivel mundial

09/11/2010

* **Se trata de la tecnología de Silicio sobre Aislante (SOI), que permitirá, a corto plazo, mejorar notablemente los dispositivos electrónicos de las próximas generaciones**

- **Esta tecnología está llamada a sustituir a la tecnología convencional de silicio en la fabricación de los circuitos integrados de los teléfonos móviles, iPads, notebooks, ordenadores y videoconsolas**

Científicos de la **Universidad de Granada** están trabajando para promocionar el uso de la tecnología de Silicio sobre Aislante (SOI) entre los grupos de diseño europeos, un logro que permitirá, a corto plazo, mejorar notablemente los dispositivos electrónicos de las próximas generaciones.

El grupo de Nanoelectrónica de la **UGR**, que lidera el profesor Francisco Gámiz, coordina desde 2003 la red Europea EUROSOI+, cuyo objetivo es promocionar el uso de la tecnología SOI entre los grupos de diseño europeos. La tecnología SOI está llamada a sustituir a la tecnología convencional de silicio en la fabricación de los circuitos integrados que serán el corazón/núcleo de los teléfonos móviles, iPads, notebooks, ordenadores y videoconsolas de las generaciones venideras.

El acceso temprano a estas tecnologías avanzadas está restringido a los grandes fabricantes, como IBM, STMicroelectrónica, Infineon, Globalfoundries, Samsung, etc.. Sin embargo, los pequeños fabricantes, los grupos de diseño de sistemas electrónicos y los grupos de investigación universitarios, futuros clientes de estas tecnologías, no pueden acceder a las mismas hasta mucho tiempo después.



Mejores prestaciones

Y es que, como apunta Francisco Gámiz, “un gran porcentaje de las prestaciones de un sistema electrónico se deben a la tecnología con que dicho sistema está fabricado, es decir, el mismo diseño experimenta una gran mejoría en sus prestaciones simplemente mejorando la tecnología con la que está fabricado”. Resulta de vital importancia, por tanto, para estos grupos de diseño el acceso temprano a estas tecnologías.

Gracias a la labor de EUROSOI+, estos grupos podrán acceder a la tecnología 20nm FDSOI, desarrollada por LETI en Grenoble (Francia). LETI y CMP (Circuits Multi Projects, Grenoble, France) han anunciado el lanzamiento de una iniciativa multiproyecto (MPW) en tecnología Fully-Depleted Silicon on Insulator de 20nm. Para reducir costes y aprovechar los recursos, este tipo de iniciativas MPW permite que diferentes grupos realicen sus diseños sobre la misma oblea. Cualquier grupo de diseño europeo tiene la opción de acceder a esta tecnología puntera a costes reducidos, lo que hará que sus diseños sean mucho más demandados que los de la competencia y los colocará en la vanguardia de la nanoelectrónica mundial.



De pie, de izquierda a derecha: Francisco García Ruiz, José

Luis Parrilla de la Torre, Francisco Gámiz Pérez, Noel Rodriguez Santiago, Juan Bautista Roldán Aranda, Francisco Martínez Carricondo, Andrés Godoy Medina, Celso Martínez y Carlos Sampedro Matarín. Sentados, de izquierda a derecha: Pedro Cartujo Casinillo, Luca Donetti, Francisco Jiménez Molinos, Isabel Tienda Luna y Blanca Biel Ruiz

Contacto: Francisco Gámiz Pérez. Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores de la [Universidad de Granada](#). Teléfono: 958 246145 Correo electrónico: LINK: --LOGIN--13a97039689055e15226001c39f5c29bugr[dot]es -> --LOGIN--13a97039689055e15226001c39f5c29bugr%5Bdot%5Des Más información en LINK: <http://www.eurosoi.org> -> <http://www.eurosoi.org>, y <http://cmp.imag.fr>

- [CANALUGR: RECURSOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN](#)
- [VER MÁS NOTICIAS DE LA UGR](#)
- [BUSCAR OTRAS NOTICIAS E INFORMACIONES DE LA UGR PUBLICADAS Y/O RECOGIDAS POR EL GABINETE DE COMUNICACIÓN](#)

<http://secretariageneral.ugr.es/>

- RESUMEN DE MEDIOS IMPRESOS DE LA UGR
- RESUMEN DE MEDIOS DIGITALES DE LA UGR
- Perfiles oficiales institucionales de la UGR en las redes sociales virtuales Tuenti, Facebook, Twitter y YouTube